

210半片20BB

双面微晶高效异质结电池

N型单晶硅



效率高达 26%



双面率
高达95%+



薄片化



PID
低衰减



N型
无LID



温度
系数低



弱光
效果



产品特征

尺寸	210mm*105mm±0.25mm
基材材料	N型单晶硅
硅片厚度	120um $\begin{matrix} +20 \\ -10 \end{matrix}$
正面(-)	20*0.04mm 主栅线(银), 58根副栅线(银), 蓝色透明导电膜(TCO)
背面(+)	20*0.04mm 主栅线(银), 100根副栅线(银), 蓝色透明导电膜(TCO)
焊接拉力	≥0.5N



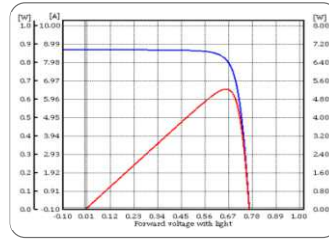
/ 该技术规格书最终解释权归珠海鸿钧所有 / 规格书中的参数如有变更, 恕不另行通知

低辐照度下电性能参数

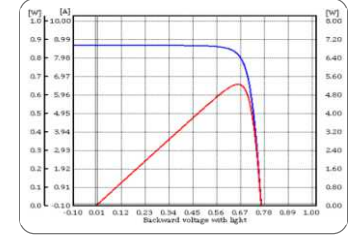
辐照度(W/m ²)	Voc	Isc
1000	1	1
900	0.99	0.9
800	0.99	0.8
600	0.98	0.6
400	0.96	0.4

* 以1000W/m²测试的 Voc(Isc)为标准,测试 Voc(Isc)随光强下降的幅度。

正面 IV 曲线



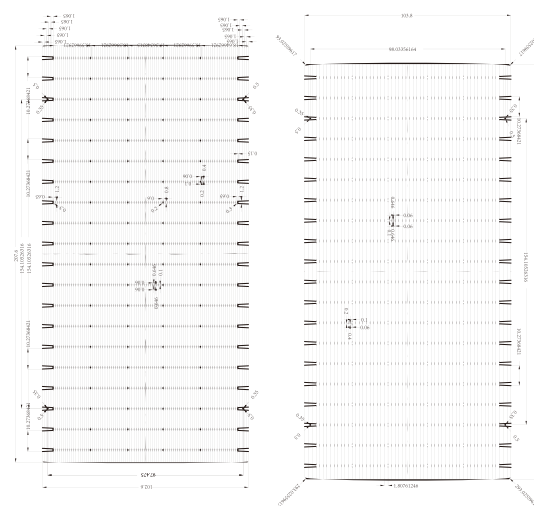
背面 IV 曲线



温度系数

Voc (%/K)	-0.27
Isc (%/K)	0.055
PMAX (%/K)	-0.26

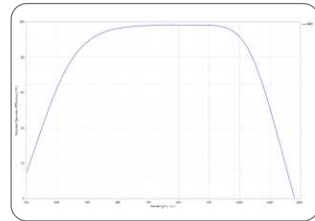
装配图纸 (mm)



包装要求

- 每批次产品厂家应附产品检验报告详单;
- 产品包装需印有产品型号、生产日期等信息。

正面光谱响应(外量子效率)



储存要求

- 干燥、室温、通风阴凉处,符合包装及储存条件下储存;
- 产品避免阳光直射、曝晒,远离热源、火源;
- 储存期限根据产品标示的生产日期和有效期而定。

正面电性能参数

效率代码	效率 (%)	最大输出功率 Pmp(W)	最大功率点电压 Vmp(V)	最大功率点电流 Imp(A)	开路电压 Voc(V)	短路电流 Isc(A)	填充因子 FF(%)
HJ-210-257	26.00%	5.7419	0.6814	8.4263	0.7522	8.8492	86.27
HJ-210-256	25.90%	5.7202	0.6797	8.4155	0.7520	8.8461	85.99
HJ-210-255	25.80%	5.6983	0.6782	8.4019	0.7517	8.8365	85.79
HJ-210-254	25.70%	5.6770	0.6761	8.3973	0.7514	8.8324	85.54
HJ-210-253	25.60%	5.6549	0.6743	8.3863	0.7510	8.8287	85.30
HJ-210-252	25.50%	5.6329	0.6718	8.3848	0.7507	8.8262	85.01
HJ-210-251	25.40%	5.6107	0.6702	8.3713	0.7505	8.8200	84.77
HJ-210-250	25.30%	5.5892	0.6681	8.3658	0.7503	8.8205	84.46
HJ-210-249	25.20%	5.5672	0.6666	8.3517	0.7499	8.8166	84.20

* 标准测试条件: 1000W/m², AM1.5, 25°C

* 以上技术参数受限于技术变更及测试, 鸿钧新能源有限公司保留最终解释权。